

2SB835

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

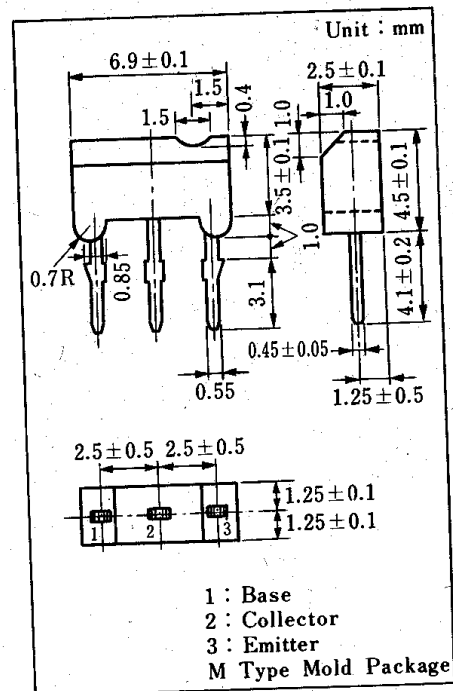
低周波出力増幅用 / AF Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- M型パッケージで自動挿入、手挿入が容易、P板に自立固定できる。
M type package suitable for automatic insertion, easier manual insertion, self-standing on PC board.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-20	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-18	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-2	A
コレクタ電流	I_C	-1	A
コレクタ損失	P_C^*	1	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積 1.0cm^2 以上、厚み 1.7mm Copper plate at the collector is more than 1cm^2 in area, 1.7mm in thickness.■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$			-1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = -18\text{V}, I_B = 0$			-10	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-20			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -1\text{mA}, I_B = 0$	-18			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$	130		360	
	h_{FE2}	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -1.5\text{A}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1\text{A}, I_B = -50\text{mA}$			-0.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$			-1.2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -6\text{V}, I_E = 50\text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -6\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$		40		pF

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	S	T
h_{FE1}	130 ~ 210	180 ~ 280	250 ~ 360